

PATENT

LAW SEARCH
REGULATIONS
EXAMINATION
AWARDS
CREATION

PPH
REGULATIONS
EXAMINATION
SMAT

TRADEMARKS
PLEDGE FEES
REGISTRATION
DIVISION
COMPANY CERTIFICATE

COPYRIGHT
PROTECTION MEASURE

ELECTRONIC MUSIC
RIGHTS MANAGEMENT
BOOKS
MOVIES
P2P
PUBLIC PROPERTY
INFORMATION

STRATEGY
INNOVATION
MANAGEMENT
ANALYSIS
VIEW
INTERNATIONAL COOPERATION
PATENT DEPLOYMENT
REPORTS
FILE WRAPPER
RESEARCH
DATA

經濟部智慧財產局

檢索歷程中常出現的檢索策略態樣

專利審查二組
2026.07~08

檢索歷程公開

- 115年1月起，發明專利初審發文檢附的**檢索報告**，均附有**檢索歷程**資訊，可揭露審查人員執行檢索的具體策略思維，提升審查行政透明。

第 號專利申請案檢索報告		附件
1.申請日：113年8月30日 2.優先權日：2024年4月19日、2024年7月5日 3.本案國際專利分類號(IPC)： <i>H10D 30/01</i> (2025.01), <i>H10D 30/62</i> (2025.01), <i>H10D 64/20</i> (2025.01) <i>B82B 1/00</i> (2006.01) 4.檢索國際專利分類號(IPC)範圍： H01L, H10D, B82B 5.檢索使用資料庫名稱： 國內外專利資料庫全域檢索系統		
關聯性代碼	引用文獻資料與相關段落處	相關聯請事項
Y	1. US 2024/0113165 A1 2024/04/04 全文，特別是說明書第[0017]、[0039]、[0041]、[0061]–[0062]、[0064]段及圖22、26	8-10
Y	2. TW 202240706 A 2022/10/16 全文，特別是說明書第[0026]–[0027]、[0036]、[0048]、[0056]、[0059]–[0060]段及圖18D、23B、23D	8-10

檢索歷程				
序號	檢索資料庫名稱	檢索式	檢索筆數	引用文獻
1	國內外專利資料庫 全域檢索系統	(緒 OR fin)@AB AND (環 [-3,3]開 OR 環[-3,3]開 OR all-around gate OR GAA) AND (虛[-3,3]開 OR 虛[-3,3]開 OR dummy [-3,3]gate) AND (牆 OR wall) AND (突 OR protru*) AND (IC=H01L* OR IC=H10D* OR IC=B82B*) AND (AD=:20240419 OR UD=:20240419 OR GD=:20240419)	319	2 TW 202240706 A
2	國內外專利資料庫 全域檢索系統	(緒 OR fin)@AB AND (環 [-3,3]開 OR 環[-3,3]開 OR all-around gate OR GAA) AND (虛[-3,3]開 OR 虛[-3,3]開 OR dummy [-3,3]gate) AND (牆 OR wall) AND (突 OR protru*) AND (IC=H01L* OR IC=H10D* OR IC=B82B*) AND (AD=:20240419 OR UD=:20240419 OR GD=:20240419)	319	1 US 2024/0113165 A1

常見檢索策略態樣

例1：一般檢索條件

序號	檢索資料庫名稱	檢索式	檢索筆數	引用文獻
1	國內外專利資料庫 全域檢索系統	((堆疊[-5,5]電晶體) AND (虛設 閘極 OR 犧牲閘極)) AND (IC=H10D-030*) AND (AD=:20250601 OR DR=:20250601)	161	2 TW 202503926 A
2	國內外專利資料庫 全域檢索系統	((stack* [-5,5] transistor*) AND (dummy gate*)) AND (IC=H10D-030*) AND (UD=:20250601 OR GD=:20250601)	46	1 US 2025/0176240 A1

常見檢索策略態樣

例2：一般檢索條件+二次動作

序號	檢索資料庫名稱	檢索式	檢索筆數	引用文獻
1	國內外專利資料庫 全域檢索系統	((堆疊[-5, 5]電晶體) AND (虛設 閘極 OR 犧牲閘極)) AND (IC=H10D-030*) AND (AD=:20250601 OR DR=:20250601) [專利家族去重]	158	
2	國內外專利資料庫 全域檢索系統	TW 202503926 A 引用	1	1 US 2023/0178552 A1

被引用
多重引用
專利家族
說明書內記載...

常見檢索策略態樣

例3：全球專利檢索系統(GPSS)【智慧檢索】

序號	檢索資料庫名稱	檢索式	檢索筆數	引用文獻
1	全球專利檢索系統(GPSS)	【智慧檢索】 [檢索去重][專利家族去重]	325	1 US 2025/0133808 A1

The screenshot displays the 'Global Patent Search System' (GPSS) interface. At the top, the logo and name '全球專利檢索系統 Global Patent Search System' are visible. Below this, there are two buttons: '智慧檢索 (Beta)' (Smart Search (Beta)) and '檢索及顯示設定' (Search and Display Settings). The '智慧檢索 (Beta)' button is highlighted. Below the buttons, there is a text box containing a detailed description of the smart search method in Chinese. At the bottom of the interface, there are search options: '指定檢索欄位' (Specify search field) set to '所有欄位' (All fields), a checkbox for '進行中英文擴展(Google翻譯)' (Perform English-Chinese expansion (Google Translate)) which is checked, and '輔助限縮條件' (Auxiliary narrowing conditions) set to 'AND' and '所有欄位' (All fields).

全球專利檢索系統
Global Patent Search System

智慧檢索 (Beta)

檢索及顯示設定 功能操作說明

一種方法，包括在半導體區上方形成虛設閘極堆疊；在虛設閘極堆疊的一側上形成源極/汲極區；移除虛設閘極堆疊以形成溝槽，其中半導體區曝光於溝槽；形成延伸至溝槽中的閘極介電層；及在閘極介電層上沉積功函數調諧層。功函數調諧層包含鋁及碳。方法進一步包括在功函數調諧層上方沉積p型功函數層，及執行平坦化製程以移除p型功函數層、功函數調諧層、及閘極介電層的多餘部分以形成閘極堆疊。|

指定檢索欄位： 所有欄位 進行中英文擴展(Google翻譯)

輔助限縮條件：
AND @ 所有欄位

常見檢索策略態樣

例4：智慧局內部使用的全域檢索系統【文獻探勘】

序號	檢索資料庫名稱	檢索式	檢索筆數	引用文獻
1	國內外專利資料庫 全域檢索系統	<p>【文獻探勘】(中英翻譯)一種方法，包括在半導體區上方形成虛設閘極堆疊；在虛設閘極堆疊的一側上形成源極/汲極區；移除虛設閘極堆疊以形成溝槽，其中半導體區曝光於溝槽；形成延伸至溝槽中的閘極介電層；及在閘極介電層上沉積功函數調諧層。 AND ((IC=H10D*) AND (UD=:20250601 OR GD=:20250601))[專利家族去重]</p>	280	1 US 2025/0133808 A1

常見檢索策略態樣

例5：參考關聯案審查意見

序號	檢索資料庫名稱	檢索式	檢索筆數	引用文獻
1	國內外專利資料庫 全域檢索系統	US 18338715 審查意見	N/A	
2	國內外專利資料庫 全域檢索系統	TW I919795 B 審查意見	N/A	1 US 2019/0103302 A1

常見檢索策略態樣

例6：參考關聯案審查意見+二次動作

序號	檢索資料庫名稱	檢索式	檢索筆數	引用文獻
1	國內外專利資料庫 全域檢索系統	US 18338715 審查意見	N/A	
2	國內外專利資料庫 全域檢索系統	US 2020135858 A1 專利家族	1	1 CN 111128891 A

常見檢索策略態樣

例7：一案兩請相同創作

序號	檢索資料庫名稱	檢索式	檢索筆數	引用文獻
1	國內外專利資料庫 全域檢索系統	((堆疊[-5,5]電晶體) AND (虛設 閘極 OR 犧牲閘極)) AND (IC=H10D-030*) AND (AD=:20250601 OR DR=:20250601)	110	
2	國內外專利資料庫 全域檢索系統	一案兩請	N/A	1 TW M123456 U

常見檢索策略態樣

例8：分割案相同發明

序號	檢索資料庫名稱	檢索式	檢索筆數	引用文獻
1	國內外專利資料庫 全域檢索系統	((堆疊[-5,5]電晶體) AND (虛設 閘極 OR 犧牲閘極)) AND (IC=H10D-030*) AND (AD=:20250601 OR DR=:20250601)	110	
2	國內外專利資料庫 全域檢索系統	分割案	N/A	1 TW I123456 B

感謝，並請指教